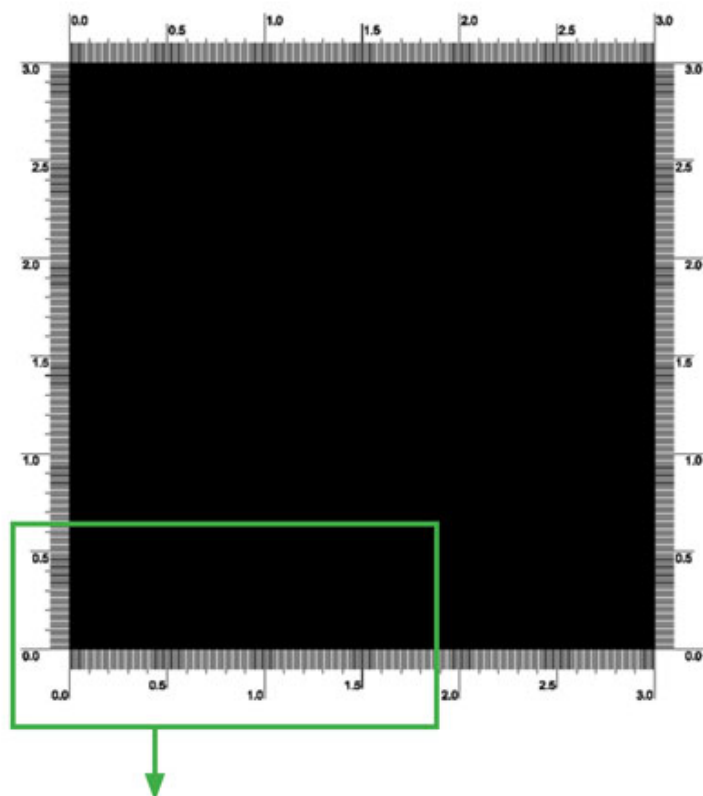


S1934 シリコンテスト試料



基板サイズ 4×4mm
3×3mm グリッド 1μm ピッチ(X,Y)

- 10μm と 100μm ピッチラインが太く、位置決めが容易
- 超平坦なシリコンに 300nm +/-30nm の深さの線が刻印されています。
- 線幅：1μm ピッチライン 200nm
10μm ピッチライン 300nm
100μm ピッチライン 400nm
- 精度：1μm+/-0.025μm 直角精度 0.01° 未満
- 各標準器にシリアルナンバーが刻印
- シリコン基板サイズ 4×4mm 厚さ 525μm +/-20μm
結晶方位 <100>
- ボロンドープシリコンウェハ 抵抗率 5-10 ohm/cm

